1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-012381

(43) Date of publication of application: 16.01.1998

(51)Int.CI.

H05B 33/14

(21)Application number : 08-158320

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

19.06.1996

(72)Inventor: KANAI HIROYUKI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element to suppress the reduction in luminance in driving by specifying the quantities of lithium contained by a negative electrode and a metal regulated in work function, respectively, in an electroluminescent element.

SOLUTION: In an organic electroluminescent element having at least a positive electrode, an organic light emitting layer, and a negative electrode successively provided on a base, the negative electrode is formed of an alloy containing magnesium, lithium, and a metal having a work function of 4.0eV or more (preferably, silver, indium). The content of the lithium is set to 0.002–2 atomic %, preferably 0.01–1.5 atomic % to the whole alloy, and the content of the metal having the work function of 4.0eV or more to 1–30 atomic %, preferably 5–20 atomic % to the whose alloy. The negative electrode layer preferably has a thickness of about 10nm or more and 1000nm or less. Thus, an organic electroluminescent element in which the stability of film of the negative electrode is improved to suppress the reduction in emitting luminance.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-12381

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H05B 33/14

H05B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平8-158320

(71)出願人 000005968

(22)出顧日

平成8年(1996) 6月19日

三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 金井 浩之

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 弁理士 長谷川 曉司

(54) 【発明の名称】 有機電界発光案子

(57) 【要約】

【課題】 陰極の膜の安定性が向上し、発光輝度の低下 が抑制された有機電界発光素子の提供。

【解決手段】 少なくとも陽極、有機発光層及び陰極が 基板上に順次設けられてなる有機電界発光素子であっ て、該陰極が、マグネシウム、リチウム及び仕事関数が 4. O e V以上の金属を含有する合金からなり、リチウ ムの含有量が 0. 002~2原子%であり且つ仕事関数 が4.0eV以上の金属の含有量が1~30原子%であ ることを特徴とする有機電界発光素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも陽極、有機発光層及び陰極が 基板上に順次設けられてなる有機電界発光素子であっ て、該陰極が、マグネシウム、リチウム及び仕事関数が 4. 0 e V以上の金属を含有する合金からなり、リチウ ムの含有量が 0. 002~2原子%であり且つ仕事関数 が4.0 e V以上の金属の含有量が1~30原子%であ ることを特徴とする有機電界発光素子。

1

【請求項2】 仕事関数が4.0eV以上の金属が金、 銀、アルミニウム、インジウム、クロム、マンガン、ニ 10 ッケル、コバルト、錫及び銅からなる群から選ばれた少 なくとも一種である請求項1に記載の有機電界発光素 子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 (以下有機EL素子と略記する) に関する。 詳しくは、 本発明は、少なくとも陽極、有機発光層及び陰極が基板 上に設けられてなる有機EL素子であって、該陰極が特 定の合金からなる有機EL素子に関する。本発明の有機 20 EL素子は、フラットパネル、ディスプレイの分野や面 発光体、表示板、標識灯等へ応用することができる。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型 の電界発光(EL)素子と しては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZn S、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類 元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドープしたものが 一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子 は、

- 1)交流駆動が必要(50~1000Hz)、
- 2)駆動電圧が高い(~200V)、
- 3) フルカラー化が困難(特に青色が問題)、
- 4) 周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、 有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるために電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的とした電極種類の最適化を行 い、芳香族ジアミンからなる有機正孔輸送層と8-ヒド ロキシキノリンのアルミニウム錯体からなる発光層を設 40 けた有機EL素子の開発 (Appl. Phys. Let t., 51巻, 913頁, 1987年) により、従来の アントラセン等の単結晶を用いたEL素子と比較して発 光効率の大幅な改善がなされている。

【OOO4】また、有機発光層としては、ポリ(pーフ ェニレンビニレン) (Nature, 347巻, 539 頁, 1990年; Appl. Phys. Lett., 6 1巻, 2793頁, 1992年)、ポリ[2ーメトキ ν , 5 - (2' - x + y - x + y + y) - 1, <math>4 - y - x = 1レンビニレン](Appl. Phys. Lett., 5 50 且つ仕事関数が4.0eV以上の金属の含有量が1~3

8巻, 1982頁, 1991年; Thin Solid Films, 216巻, 96頁, 1992年; Nat ure, 357巻, 477頁, 1992年)、ポリ(3 ーアルキルチオフェン)(Jpn. J. Appl. Ph ys., 30巻, L1938頁, 1991年; J. Ap pl. Phys., 72巻, 564頁, 1992年) 等 の高分子材料の開発や、ポリビニルカルバゾール等の高 分子に発光材料と電子移動材料を混合した素子(応用物 理, 61巻, 1044頁, 1992年) も開発されてい る。

【0005】以上に示したような有機EL素子において は、通常、陽極としてはインジウム錫酸化物(ITO) のような透明電極が用いられるが、陰極に関しては電子 注入を効率よく行うために仕事関数の低い金属電極が用 いられる。例えばアルカリ金属以外の複数の金属を含有 し、少なくとも一種の金属の仕事関数が4.0eV以下 の合金 (特開平2-15595号公報)、カルシウム (Appl. Phys. Lett., 68巻, 147 頁、1996年)や、アルミニウムに微量のリチウムを 添加したアルミニウム合金(特開平5-121172号 公報)等を挙げることができる。これらの金属は反応性 が高いため、劣化を防止するために、更に上部に保護層 を設ける(特開平4-233194号公報)等の方法が 試されているが、輝度低下の抑制においては十分な特性 が得られていないのが現状である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】これまでに開示されて いる有機EL素子では、EL発光は陽極から注入された 正孔と陰極から注入された電子との再結合によりもたら 30 される。一般に、キャリアーの注入は、電子の場合、陰 極と有機発光層との界面における注入障壁を乗り越えて 行われなければならない。この電子注入障壁を低くして 注入効率を向上させるために、マグネシウム合金やカル シウム等の低仕事関数の金属電極が陰極として使用され ているが安定性に欠けるため、輝度低下が激しいという 欠点を有している。本発明の課題は、駆動時における輝 度低下が抑制された有機E L素子を提供することにあ る。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を 解決するために鋭意検討した結果、陰極としてマグネシ ウム、リチウム及び仕事関数が4.0eV以上の金属を 含有する合金系を用いることにより輝度劣化が抑制され ることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0008】即ち、本発明は、少なくとも陽極、有機発 光層及び陰極が基板上に順次設けられてなる有機電界発 光素子であって、該陰極が、マグネシウム、リチウム及 び仕事関数が4.0 e V以上の金属を含有する合金から なり、リチウムの含有量が 0.002~2原子%であり

3

0原子%であることを特徴とする有機電界発光素子、にある。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の有機E L素子について添付図面に従い説明する。図1は本発明の有機E L素子の構造例を模式的に示す断面図であり、1は基板、2は陽極層、3は有機発光層、4は陰極層を各々表わす。基板1は本発明の有機E L素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシート等が用いられるが、ガラス板や、ポリエステル、ポリメタアクリレート、ポリカーボネート、ポリスルホン等の透明な合成樹脂基板が好ましい。【0010】基板1上には陽極層2が設けられるが、こ

【0010】基板1上には陽極層2が設けられるが、こ の陽極層2としては通常、アルミニウム、金、銀、ニッ ケル、パラジウム、テルル等の金属、インジウム及び/ 又は錫の酸化物等の金属酸化物やヨウ化銅、カーボンブ ラック、或いは、ポリ(3-メチルチオフェン)等の導 電性高分子等により構成される。導電層の形成は通常、 スパッタリング法、真空蒸着法等により行われることが 多いが、銀等の金属微粒子或いはヨウ化銅、カーボンブ 20 ラック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉 末等の場合には、適当なバインダー樹脂溶液に分散し、 基板上に塗布することにより形成することもできる。更 に、導電性高分子の場合は電界重合により直接基板上に 薄膜を形成したり、基板上に塗布して形成することもで きる (Appl. Phys. Lett., 60巻, 27 11頁, 1992年)。上記の導電層は異なる物質で積 層することも可能である。

【0011】陽極層2の厚みは、必要とする透明性により異なるが、透明性が必要とされる場合は、可視光の透 30 過率が60%以上、好ましくは80%以上透過することが望ましく、この場合、厚みは、通常、5~1000 nm、好ましくは10~500 nm程度である。不透明でよい場合は陽極層2は基板1と同一でもよい。また、更には上記の陽極層を異なる物質で積層することも可能である。

【0012】陽極層2の上には有機発光層3が設けられるが、有機発光層3は、電界を与えられた電極間において、陽極から注入された正孔と陰極から注入された電子が効率よく再結合し、発光する材料から形成される。通常、この有機発光層3は発光効率の向上のために、図2に示すように、正孔輸送層3aと電子輸送層3bに分割して機能分離型にすることが行われる(Appl. Phys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年)。また、更に正孔輸送層3aは、図3に示すように正孔の注入を主に担当する正孔注入層3a1と正孔の輸送を主に担う正孔輸送層3a2に分離し駆動特性の向上が計られている(Appl. Phys. Lett., 65巻, 807頁, 1994年)。

【0013】図3の機能分離型素子において、正孔注入 50 るつぼを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、るつぼと

層3a1の材料としては、陽極層2からの正孔注入効率 が高いことが望まれる。そのためには、イオン化ポテン シャルが小さいことが要求される。更に陽極層2との密 着性が高く安定していることが望まれる。このような材 料としては、銅フタロシアニン、スターバーストアミン (Mol. Cryst. Liq. Cryst., 211 巻, 431頁, 1992年、Appl. Phys. Le tt.,65巻,807頁,1994年) 等を挙げるこ とができる。これらは、スピンコート法や真空蒸着法等 によって成膜される。正孔注入層の膜厚は通常1~10 0 nm、好ましくは5~50 nmである。この薄い膜を 一様に形成するためには、真空蒸着法がよく用いられ る。正孔注入層3a1の上には、正孔輸送層3a2が積 層される。正孔注入層によって注入された正孔を正孔輸 送層へ注入されるために、正孔輸送層のイオン化ポテン シャルが正孔注入層のイオン化ポテンシャルより小さい か同程度であることが望まれる。また、正孔移動度が大 きく、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生し にくいことが要求される。

【0014】このような正孔輸送化合物としては、例え ば、特開昭59-194393号公報及び米国特許第 4, 175, 960号明細書の第13~14欄に解説さ れる、N, N' ージフェニルーN, N' ー (3-メチルフェニル) -1, 1' -ビフェニルー4, 4' -ジアミ ン:1, 1' ービス(4 ー ジーp ートリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン: 4, 4'ービス(ジフェニルアミ ノ)クワドロフェニル等の芳香族アミン系化合物、特開 平2-311591号公報に示されるヒドラゾン化合 物、米国特許第4,950,950号明細書に示される シラザン化合物等が挙げられる。これらの化合物は、単 独で用いるか、必要に応じて、各々、混合して用いても よい。上記の化合物以外に、ポリビニルカルバゾールや ポリシラン(Appl. Phys. Lett., 59 巻, 2760頁, 1991年) 等の高分子材料が挙げら れる。

【0015】上記の有機正孔輸送材料は塗布法或いは真空蒸着法により形成される。塗布の場合は、有機正孔輸送化合物を一種又は二種以上と必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や、レベリング剤等の塗布性改良剤等の添加剤を添加し溶解した塗布溶液を調製し、スピンコート法等の方法により陽極層、又は、正孔注入層上に塗布し、乾燥して有機正孔輸送層を形成する。バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、50重量%以下が好ましい。

【0016】真空蒸着法の場合には、有機正孔輸送材料 を真空容器内に設置されたるつぼに入れ、真空容器内を 適当な真空ポンプで10⁻⁶ Torrにまで排気した後、 るつぼを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、るつぼと 向き合って置かれた基板上に層を形成する。正孔輸送層 の膜厚は、通常、10~300nm、好ましくは30~ 100nmである。このように薄い膜を一様に形成する ためには、真空蒸着法がよく用いられる。

【0017】正孔輸送層の材料としては有機化合物の代 わりに無機材料を使用することも可能である。無機材料 に要求される条件は、有機正孔輸送化合物と同じであ る。正孔輸送層に用いられる無機材料としては、p型水 素化非晶質シリコン、p型水素化非晶質炭化シリコン、 p型水素化微結晶性炭化シリコン、或いは、 p型硫化亜 10 鉛、p型セレン化亜鉛等が挙げられる。これらの無機正 孔輸送層はCVD法、プラズマCVD法、真空蒸着法、 スパッタ法等により形成される。無機正孔輸送層の膜厚 も有機正孔輸送層と同様に、通常、10~300nm、 好ましくは30~100nmである。

【0018】正孔輸送層の上には電子輸送層3bが設け られるが、電子輸送層は、電界を与えられた電極間にお いて陰極からの電子を効率よく正孔輸送層の方向に輸送 することができる化合物より形成される。有機電子輸送 化合物としては、陰極層 4 からの電子注入効率が高く、 且つ、注入された電子を効率よく輸送することができる 化合物であることが必要である。そのためには、電子親 和力が大きく、しかも電子移動度が大きく、更に安定性 に優れトラップとなる不純物が製造時や使用時に発生し にくい化合物であることが要求される。

【0019】このような条件を満たす材料としては、テ トラフェニルブタジエン等の芳香族化合物(特開昭57 -51781号公報)、8-ヒドロキシキノリンのアル ミニウム錯体等の金属錯体(特開昭59-194393 号公報)、シクロペンタジエン誘導体(特開平2-28 30 れる。このような電子輸送材料としては、 9675号公報)、ペリノン誘導体(特開平2-289 676号公報)、オキサジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報)、ビススチリルベンゼン誘導体 (特開平1-245087号公報、同2-22484 号公報)、ペリレン誘導体(特開平2-189890号 公報、同3-791号公報)、クマリン化合物(特開平 2-191694号公報、同3-792号公報)、希土 類錯体(特開平1-256584)、ジスチリルピラジ*

* ン誘導体(特開平2-252793号公報)、p-フェ ニレン化合物(特開平3-33183号公報)、チアジ アゾロピリジン誘導体(特開平3-37292号公 報)、ピロロピリジン誘導体(特開平3-37293号 公報)、ナフチリジン誘導体(特開平3-203982 号公報)等が挙げられる。

【0020】これらの化合物を用いた有機電子輸送層 は、電子を輸送する役割と、正孔と電子の再結合の際に 発光をもたらす役割を同時に果しており、発光層を兼ね ている。有機正孔輸送化合物が発光機能を有する場合 は、有機電子輸送層は電子を輸送する役割だけを果た す。

【0021】素子の発光効率を向上させると共に発光色 を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリンのア ルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレー ザ用蛍光色素をドープすること(J. Appl. Phy s.,65巻,3610頁,1989年) も行われてい る。本発明においても上記の有機電子輸送材料をホスト 材料として各種の蛍光色素を10~~~10モル%ドープ することにより、素子の発光特性を更に向上させること ができる。電子輸送層3bの膜厚は、通常、10~20 Onm、好ましくは30~100nmである。

【0022】有機電子輸送層も有機正孔輸送層と同様の 方法で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用 いられる。有機EL素子の発光効率を更に向上させる方 法として、電子輸送層3bの上に更に他の電子輸送層3 cを積層することが考えられる(図4参照)。この電子 輸送層 3 c に用いられる化合物には、陰極からの電子注 入が容易で、電子の輸送能力が更に大きいことが要求さ

[0023]

【化1】

$$t - B u - O$$

[0024] 【化2】

(4)

【0025】等のオキサジアゾール誘導体(App1. Phys. Lett., 55巻, 1489頁, 1989 年) やそれらを PMMA等の樹脂に分散した系 (App 1. Phys. Lett., 61巻, 2793頁, 19 92年)、又は、n型水素化非晶質炭化シリコン、n型 硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられる。電子輸送 層3cの膜厚は、通常、5~200nm、好ましくは1 0~100nmである。

【0026】また、機能分離を行わない単層型の有機発 50

光層3としては、先に挙げたポリ(pーフェニレンビニ レン) (Nature, 347巻, 539頁, 1990 年; Appl. Phys. Lett., 61巻, 279 3頁, 1992年)、ポリ[2-メトキシ, 5-(2' ーエチルヘキソキシ) -1, 4-フェニレンビニレン] (Appl. Phys. Lett., 58巻, 1982 頁, 1991年; Thin Solid Films, 216巻, 96頁, 1992年; Nature, 357 巻、477頁、1992年)、ポリ(3-アルキルチオ

フェン) (Jpn. J. Appl. Phys., 30 巻, L1938頁, 1991年; J. Appl. Phy s., 72巻, 564頁, 1992年) 等の高分子材料 や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に発光材料と電 子移動材料を混合した系(応用物理, 61巻, 1044 頁, 1992年) がある。

【0027】この上に、陰極層4が形成される。陰極層 4 は有機発光層 3 b に電子を注入する役割を果たす。ま た、長期間安定に動作するために膜質が安定しているこ とも要求される。このような条件を満たす材料として、 マグネシウム、リチウム及び仕事関数が4. 0eV以上 の金属を含有する合金が好適であることを本発明者は見 出した。

【0028】電子の注入を容易にするため、リチウムが 添加されるが、その含有量は、合金全体に対して0.0 02~2原子%、好ましくは0.01~1.5原子%で ある。仕事関数が4.0 e V 以上の金属は、主として膜 の安定化を増加させる目的で添加される。このような金 属としては、例えば、金、銀、アルミニウム、インジウ ム、クロム、マンガン、ニッケル、コバルト、錫、銅等 20 を挙げることができる。これらの中、銀、インジウムが 好ましい。仕事関数が4.0 e V以上の金属含有量は、 合金全体に対して1~30原子%、好ましくは5~20 原子%である。

【0029】また、陰極層の膜厚は通常1mm以上10 000nm以下であり、好ましくは10nm以上100 0 nm以下である。更にこの上に保護層として、他の金 属を成膜することも可能である。これらの膜の成膜方法 としては、それぞれの金属を独立の蒸発源として用いる 同時蒸着法により成膜する方法、予め合金を作製してお 30 き、単一蒸発源から成膜する方法等を挙げることができ る。仕事関数が4.0eV以上の金属を混合することに より、陰極膜の安定性が増し、その結果電子注入が安定 に行われるようになり、結果的に輝度の劣化が緩やかに なったものと思われる。

[0030]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説 明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実*

【0036】次に、有機電子輸送層および発光層の材料 として、下記構造式(E-1)で表わされる8-ヒドロ キシキノリンのアルミニウム錯体、Al(C,H,N) O) 3 を用い、ドーパント材料としては、下記構造式

(D-1) で表わされるルブレンを用いて上記有機正孔 輸送層3a2の上に同様にして蒸着を行なった。この時 のホスト材料の入ったるつぼの温度は310~320℃ 50

* 施例の記載に限定されるものではない。

【0031】実施例1

図2に示す構造を有する有機EL素子を以下の方法で作 製した。ガラス基板上にインジウム・スズ酸化物(IT O) 透明導電膜を120nm堆積したものをアセトンで 超音波洗浄、純水で水洗、イソプロピルアルコールで超 音波洗浄、乾燥窒素で乾燥、UV/オゾン洗浄を行った 後、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が3× 10°Tor以下になるまで油拡散ポンプを用いて排 気した。

【0032】有機正孔注入層材料として、下記構造式 (I-1)で表わされる銅フタロシアニン化合物をモリ ブデンモートに入れ、加熱して蒸着を行った。この時の 真空度は2×10°Torrで、蒸着速度は2nm/秒 であり、蒸着時間1分45秒で膜厚20nmの有機正孔 注入輸送層 3 a 1を得た。

[0033]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
N & C_0 & N \\
N & N & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
N & N & N & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
N & N & N & N
\end{array}$$

【0034】次に有機正孔輸送層材料として、下記構造 式(H-1)で表わされる芳香族アミン化合物をセラミ ックるつぼに入れ、るつぼの周囲のタンタル線ヒーター で加熱して蒸着を行った。この時のるつぼの温度は、2 20~260℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は3 ×10⁻⁶Torrで、蒸着時間2分00秒で膜厚60n mの有機正孔輸送層3a2を得た。

[0035]

【化4】

(H-1)

の範囲で、ドーパントの入ったるつぼの温度は130~ 140℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は3×10 ⁻⁶ Torr、蒸着時間は3分30秒、膜厚は75nmで あった。この時のドーパントの濃度は1.1%であっ た。

[0037]

【化5】

9

[0038]

【化6】

【0039】最後に陰極として、マグネシウムと銀とリチウムの合金電極を三元同時蒸着法によって膜厚50nmで蒸着した。この時の真空度は3×10°Torr、蒸着時間は4分30秒で光沢のある膜が得られた。マグネシウム、銀及びリチウムの含有量はそれぞれ、91.8原子%、7.8原子%及び0.4原子%であった。この素子を電流密度90mA/cm²の定電流でこの素子を駆動した時、初期輝度の8割まで輝度が低下する時間は10時間であった。

【0040】実施例2

陰極の組成をマグネシウムとインジウムとリチウムの合金電極に変えた他は実施例1と同様にして素子を作製した。この時のマグネシウム、インジウム及びリチウムの30含有量はそれぞれ9.0.1原子%、8.5原子%及び1.4原子%であった。この素子を電流密度90mA/cm²の定電流で駆動した時、初期輝度の8割まで輝度が低下する時間は10時間であった。

【0041】比較例1

陰極の組成をマグネシウムと銀の合金電極に変えた他は 実施例1と同様にして素子を作製した。この時のマグネ シウムと銀の含有量は88.5原子%、11.5原子% であった。この素子を電流密度90mA/cm²の定電 流で駆動した時、初期輝度8割まで輝度が低下する時間 40 は0.5時間であった。

【0042】比較例2

陰極の組成をマグネシウムと銀の合金電極に変えた他は 実施例1と同様にして素子を作製した。この時のマグネ シウム、銀及びリチウムの含有量はそれぞれ88.2原* *子%、8.6原子%及び3.2原子%であった。この素子を電流密度90mA/cm²の定電流で駆動した時、初期輝度の8割まで輝度が低下する時間は3.5時間であった。

10

【0043】比較例3

陰極の組成をマグネシウムと銀の合金電極に変えた他は 実施例1と同様にして素子を作製した。この時のマグネ シウム、銀及びリチウムの含有量はそれぞれ55.1原 子%、44.6原子%及び0.3原子%であった。この 3原子を電流密度90mA/cm²の定電流で駆動した 時、初期輝度の8割まで輝度が低下する時間は3.5時 間であった。

[0044]

【発明の効果】本発明の有機電界発光素子によれば、少なくとも陽極(アノード)、有機発光層、陰極(カソード)、が基板上に順次設けられ、しかも、陰極材料としてマグネシウムとリチウムと仕事関数が4.0 e V以上の金属を含有する合金を使用しているため、陰極の膜の安定性が向上し、結果として発光輝度の低下を抑制することができた。従って、本発明のE L素子はフラットパネル・ディスプレイ(例えばOAコンピュータ用や壁掛けテレビ)の分野や面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源)、表示板、標識灯への応用が考えられ、その技術的価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の一例を示した模式断面図である。

【図2】本発明の有機EL素子の別の例を示した模式断面図である。

【図3】本発明の有機EL素子の別の例を示した模式断面図である。

【図4】本発明の有機EL素子の別の例を示した模式断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極層
- 3 有機発光層
- 3 a 正孔輸送層
- 3 a 1 正孔注入層
- 3 a 2 正孔輸送層
- 3 b 有機電子輸送層
- 3 c 3 bとは異なる化合物で構成される有機電子輸送層

4 陰極層

【下図】 [区図] [图S] 【I図】

特開平10-12381